

2SA564, 2SA564A

2SA564, 2SA564A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ型/Si PNP Epitaxial Planar

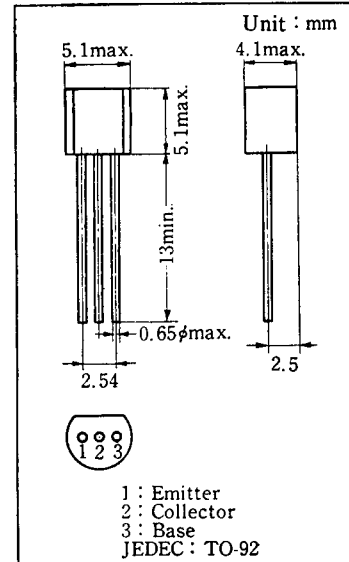
一般増幅用/General Use for Small Signal
2SC828, 2SC828A とコンプリメンタリ/Complementary pair with
2SC828, 2SC828A

特徴/Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が大きい。/High h_{FE}
- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。/Low $V_{CE(sat)}$

最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	25	V
		45	
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	25	V
		45	
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CM}$	100	mA
コレクタ電流	$-I_C$	50	mA
コレクタ損失	P_C	250	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$



電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CBO}$	$-I_C=10\mu\text{A}$	25			V
			45			
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CEO}$	$-I_C=2\text{mA}$	25			V
			45			
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EBO}$	$-I_E=10\mu\text{A}$	5			V
コレクタシャ断電流	$-I_{CBO}$	$-V_{CB}=10\text{V}, I_E=0$		0.001	1	μA
コレクタシャ断電流	$-I_{CEO}$	$-V_{CE}=25\text{V}$			10	μA
		$-V_{CE}=45\text{V}$			10	
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$-V_{CB}=5\text{V}, I_E=2\text{mA}$	65	250	700	
トランジション周波数	f_T	$-V_{CB}=10\text{V}, I_E=1\text{mA}$		80		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C=50\text{mA}, -I_B=2.5\text{mA}$		0.3		V
コレクタ出力容量	C_{ob}	$-V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$		2.7		pF

* h_{FE} ランク分類/ h_{FE} Classifications

h_{FE}	65~130	90~180	130~260	180~360	260~520	360~700
分類	O	P	Q	R	S	T